IIII 身近な宇宙,落下塔による微小重力実験 IIII(解説)

落下塔を活用したホットディスク法による金属融液の 熱伝導度測定における対流効果の検証

永井 秀明

Verification of Convection Effect on Thermal Conductivity Measurement of Molten Metals by Hot-disk Method using Drop Tower

Hideaki NAGAI

Abstract

Microgravity circumstance is useful for measurement of thermal conductivity of molten metals, because thermal convection is suppressed. To measure the thermal conductivities of molten metals systematically under microgravity, it needs many chances for the microgravity experiments. The short-duration microgravity of drop tower experiments is suitable for this purpose. In this study, the thermal conductivities of several molten metals were measured by hot-disk method under short-duration microgravity of drop tower experiments to study the influence of convection, limitation of time and space. In addition, the thermal conductivities of molten metals without convection effect were compared with those derived from Wiedemann-Franz law. The thermal conductivities of Hg and Bi melts were good agreement with those derived from Wiedemann-Franz law, but those of Sn, Si and InSb melts were different from those derived from Wiedemann-Franz law.

Keyword(s): Thermal conductivity, Molten metal, Hot-disk Method, Drop tower, Convection

1. はじめに

近年,コンピュータの性能の進歩のおかげもあり, 様々な物理現象をシミュレーションにより解き明かす計 算科学が急速に進歩している. その中で, 鋳造や溶接, 単結晶育成などの融体が関与する製造プロセスは、物質 移動とともに熱の移動の管理が生成物の性状、ひいては 物性に影響を与えるため、厳密な管理が必要な分野の一 つである.この分野はこれまでは経験的,あるいは半経 験的に熱移動の制御を行っており、スケールアップや複 雑形状に対応するために、シミュレーションによる効率 化や設計へのフィードバックの期待が高まっている. た だし、シミュレーションを行うためには、(1)初期条件、 (2)対象物の熱物性値が必要である.精度の高いシミュレ ーションを行うためには、熱物性値として信頼性が高い ものが必要であり、シミュレーション結果に多大な影響 を与える. このため, 例えば, Si デバイスメーカーへの アンケートを元に、固体および液体(すなわち、融液) の Si 熱物性値の重要度について調べた結果, まだまだ融 液状態の熱物性値が十分ではないとの意見が寄せられて いる¹⁾. また、欧州では、次世代ジェットエンジンタービ ンブレードなどを対象とした、高温融体熱物性計測のプロジェクトが行われてきており²⁰,最近における国際宇宙 ステーションでの高温融体熱物性計測に発展してきている. その中でも,Siを初めとする金属融液の熱伝導度については,熱移動を司る重要なパラメータであり,注目度は高い.

金属融液の熱伝導度測定の歴史を紐解いてみると、そ の測定のほとんどが 1960 年代から 1970 年代に行われて おり、Y.S. Touloukian らがまとめた金属や合金の熱伝導 度についてはいまでもこの値が推奨値として用いられて いる場合が多い³⁾. この当時,測定法の主役は平行平板型 に代表される定常法である. この方法はフィックの法則 に従った測定法であり、熱移動の定常状態を達成するた めに長時間の測定時間を必要とする. そのため、固体試 料では問題とならない熱対流の影響が金属融液では顕著 に現れる. 当時の測定でこのことに触れた記述は皆無で あり、今一度検証の必要性がある. この熱対流の効果を 無視できる環境として、微小重力環境が挙げられる. こ の微小重力環境下で金属融液の熱伝導度測定を系統的に 行えば上記の問題に明確な答えを与えてくれると考えら れる. 既に中村らが航空機やロケットによる弾道飛行,

産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 〒305-8565 茨城県つくば市東 1-1-1 中央第5

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Advanced Manufacturing Research Institute,

Central 5, 1-1-1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8565, Japan.

⁽E-mail: hideaki-nagai@aist.go.jp)

大型落下シャフトによる自由落下を用いた微小重力環境 下で液状金属の熱伝導度を測定し,微小重力の効果につ いて議論をしている⁴⁶⁰.ただし,これらの大型の設備を 必要とする微小重力環境を利用できる機会は限られてお り,系統的な議論をするにはより多くの機会が必要であ る.一方,比較的小型の落下塔は,本格的な宇宙実験の 補助的設備として考えられており,微小重力時間は 0.5~ 1s 程度であるが,繰り返し性に優れている.このため, 上記の目的に使用できれば系統的な測定が可能となる. また,対流の影響を排除すると言う観点では,静磁場を 用いた Hg の熱伝導度測定 ^{7,8)}や電磁浮遊と静磁場を組み 合わせた無容器下での Si 融液等の熱伝導度測定 ^{9,10)}など の擬似微小重力環境下での報告もなされている.

本研究では,繰り返し測定の可能な小型落下塔を用いた短時間微小重力環境下で室温から高温までの幅広い金属融液の熱伝導度を系統的に測定するための測定方法を開発してきた¹¹⁻¹⁴⁾.短時間微小重力環境としては,産業技術総合研究所,北海道センターで保有している 10m 落下塔(2 重カプセル方式,微小重力時間:1.4s,微小重力の質:10⁻³G)を用いた(Fig. 1).微小重力下での熱伝導度の測定方法としては,コンパクトかつ堅牢で,1s 程度で測定が可能な方法としてホットディスク法を用いた.ここでは,落下塔を活用したホットディスク法による熱伝導度測定の信頼性に強い影響を及ぼす対流の効果を中心に検証を行うことを目的としている。更に、無対流下で得られた金属融液の熱伝導度とWiedemann-Franz則との比較を行った.



Fig. 1 AIST 10m drop tower.

2. 実験方法

2.1 ホットディスク法

ホットディスク法は,熱伝導度測定法の非定常法の1 つであり, 主に絶縁固体の熱伝導度測定に用いられてい る細線加熱法(ホットワイヤー法)と類似点は多い.ホ ットワイヤー法は、センサー部である細線をステップ状 に通電加熱し,その時の細線の温度変化が外部環境,す なわちセンサー周辺に存在する測定対象である試料の熱 物性によって変化する挙動を解析解と照らし合わせて熱 伝導度を求める方法である.ホットディスク法では、そ のセンサー部が金属薄膜で2 重螺旋状に加工されており, あたかも円盤状の発熱体(ホットディスク)として機能 し、通電加熱で得たセンサーの温度変化を検出する役割 も担っている.2 重螺旋状になっているため、ホットワイ ヤー法に比べてセンサー部がコンパクトになり、金属融 液の熱伝導度測定時の融液量の減量、すなわち小型化に も役立っている.また,センサー部の金属箔は絶縁膜で 覆われており、電気伝導性のある金属融液の熱伝導度測 定にも対応できる.

ここではホットディスク法の測定原理の概要について 説明する.測定原理の詳細については別の文献を参考に して欲しい^{15,16)}.

ホットディスク法では、ホットディスクセンサーに一 定電流を通電することによって発熱させ、その時のホッ トディスクセンサーの温度変化と相関のある電気抵抗変 化を測定する.ホットディスセンサーの電気抵抗の時間 依存性は次のように表すことができる.

$$R(t) = R_0 \left[(1 + \alpha \Delta T_i) + \alpha P_0 \left(\pi^{\frac{3}{2}} d\lambda \right)^{-1} D(\tau) \right]$$
(1)

R(t):時間 t におけるホットディスクセンサーの電気抵抗Ro:測定前のホットディスクセンサーの電気抵抗 $<math>\alpha: ホットディスセンサーの電気抵抗の温度依存性$ $<math>\Delta T_i: ホットディスクセンサーの金属薄膜と絶縁膜表面と$ の温度差

 $P_0: 全出力$

d:ホットディスクセンサーの半径

λ:測定試料の熱伝導度

D(τ):無次元時間τに依存したホットディスクセンサーの 温度上昇の理論解の無次元関数

このように、ホットディスクセンサーの電気抵抗変化は 只1つの無次元時間での関数として表すことができる.では (2)式のように表すことができる.

$$\tau = \left(\frac{t}{\theta}\right)^2, \quad \theta = \frac{d^2}{\kappa_s}$$
(2)

 $\boldsymbol{\theta}$: Characteristic time

κs:測定試料の熱拡散率

 θ が(2)式によって導かれる値の時,(1)式のR(t)と $D(\tau)$ の間には直線関係が成り立つことから、その直線の傾きから試料の熱伝導度 λ を求めることができる.その際に(1)式

が最も直線に近くなるように無次元時間 τ を変化させて D(τ)が決定される.実際の解析では,(1)式が最も直線に フィッティングできるように θ 値を変数として計算してい る.また,その時の θ 値から試料の熱拡散率が求められる. 解析に用いられる測定時間は,熱伝導度と熱拡散率を同 時に求める場合には θ 値の概ね 0.5 倍~1 倍が適切である. ただし,その範囲を大幅に外れる場合でも、単位体積あ たりの比熱 ρC_p (ρ :密度, C_p :比熱)を既知として代入す ることで,熱伝導度を求めることができる.この時,熱 拡散率は, $\lambda = \rho C_p \cdot \kappa_s$ の関係より従属的に決定される.

通常,熱伝導度を理論的に解析する際には試料は無限 に大きいものとして取り扱うが,現実には試料はある有 限の大きさを持っている.そのため,解析する際には試 料サイズに適した測定範囲が存在する.ホットディスク 法では,ホットディスクセンサーから発生した熱が試料 内を伝わり,その熱が試料の末端まで届かない範囲で測 定することを想定している.測定中にホットディスクセ ンサーから発生した熱が試料中を伝わった距離を「プロ ーブ深さ(Δ_p)」と呼び,(3)式のように表される.

$$\Delta_p = \beta(\kappa_s t)^{\frac{1}{2}} \tag{3}$$

有限の大きさを持つ試料の場合には測定に使用できる範囲を判断する際に使用し、 β は定数で通常は $\beta=2$ が用いられている.



Fig. 2 Hot-disk equipment for drop tower experiments. (a):System components of hot-disk equipment. (b):Set up configuration of drop tower experiments.



Fig. 3 Hot-disk sensors for thermal conductivity measurement of molten metals.

2.2 実験装置

ホットディスク装置の外観図を Fig.2(a)に示す.計測部 は、(1)電流供給源と電圧測定器を兼ねたソースメーター (Keithley 2400) と(2)機器制御とデータ記録・解析を兼 ねたノート型コンピュータ、(3)測定開始用タイマーから なる.測定部は,基本的には、(4)試料容器と(5)ホットデ ィスクセンサーからなり,必要に応じて温度制御用の電気炉 や雰囲気制御用のチャンバーを用意した. Figure 2(b)は, 落下塔実験用の内カプセルに搭載した様子を表している. 今回,使用したホットディスクセンサーは、室温付近で の測定は、半径 3.2mm の Ni 箔製カプトン被覆ホットデ ィスクセンサー(市販品) であり、200℃以上の温度域で は、半径 2.75mm(熔融 Si 用)と半径 3.05mm(その他) の Mo 箔製 AIN 被覆ホットディスクセンサー(筆者製作) を用いた(Fig. 3).

2.3 実験試料及び手順

本実験に用いた試料を **Table 1** に示す. Hg の場合は, 室温で液体のため,スチロール容器(内径約 40mm)に 入れた試料にホットディスクセンサーを垂直に差し込ん

Sample	Droduct commonly	Purity	
	Product company	(%)	
Hg	Wako Pure Chemical	99.5	
Bi	Wako Pure Chemical	99.999	
Sn	Wako Pure Chemical	99.999	
Si	Shin-Etsu Handotai	99.999999999	
InSb	Koujyundo Chemical	99.999	

 Table 1 Sample list for drop tower experiments of thermal conductivity measurements.

で液漏れしないように 2 重にシールしたものを測定部と した. それ以外の試料の場合は, 内径 17mm, 高さ 50-60mm のタンマン管(ニッカトー製,材質:アルミナ [SSA-S]) にホットディスクセンサーを挿入し, ホットデ ィスクセンサーがタンマン管の直径の中心にある状態で, 熔融時にホットディスクセンサーの測定部である二重ら せん部が十分に浸漬するだけの試料を隙間にまんべんな く入れた. それを雰囲気制御型電気炉に入れ, 真空排気 後にアルゴンガスで置換した. その後, 所定の温度まで 加熱を行った. 電気炉を用いた温度制御を行う場合には, 熱対流の影響を抑制するために、試料上部が下部より温 度が高くなるように試料配置を調整した.また,熱伝導 度測定では、測定前の熱的安定状態が基本となるため、 温度が一定になってからの保持時間を 5-10 分程度設けた. 落下塔実験では、測定時にホットディスクセンサーから 発する熱による試料融液の擾乱を抑制するために落下後 0.1s 程度経ってから熱伝導度測定を行った. 常重力下の 実験もほぼ同様の構成,手順で行った.

結果及び考察

3.1 落下塔を用いたホットディスク法における熱 伝導度測定の信頼性の検証

まず,熱伝導度を正確に測定する上で,対流の影響が 抑制されているかどうかを議論しておくことは重要であ る.微小重力環境を考えた場合には,密度差による熱対 流とともに表面張力差によるマランゴニ対流も重要な要 素である.

Figure 4 は、代表的な測定時のホットディスクセンサ ーの電気抵抗変化を示している.常重力下における測定 では,典型的な電気抵抗値の上昇パターンを示しており, この結果だけでは対流の影響について議論はできない. 一方,微小重力下では,測定初期においては常重力下と 比較してわずかに高い値を示している.このことから, 微小重力下では測定初期において何らかの原因でホット ディスクセンサー周辺の熱伝導度が低下していることが わかる.ここで考えられる主な原因は,(1)試料融液の対 流の抑制と(2)ホットディスク界面での気泡の発生による 被覆である.どちらも見かけ上の熱伝導度の低下に寄与 するが,測定結果だけからこれらを判断することはでき



Fig. 4 Typical plots of resistance profile of hot-disk sensor as a function of measurement time for molten InSb at 977 K.

ない.特に(2)については,Hg 以外の高温融液を用いる場 合にはその反応性の高さから注意が必要である.本研究 の場合,高温測定に用いたホットディスクセンサーの被 覆材には耐食性の高い AIN を用いており,Si 融液の場合 にはわずかに反応生成相ができているが¹²⁾,ほとんどの 試料融液とは反応していない^{13,14)}.また,測定温度範囲 も試料融液の蒸気圧の低い範囲で行っており,気泡の発 生する要因はほとんどない.このことから,微小重力下 における試料融液の熱伝導度の低下は,(1)試料融液の対 流の抑制の影響によるものと考えられる.また,微小重 力環境が終了する 1.3s 付近においては大幅な電気抵抗値 の減少が見られ,制動時における過重力による熱対流及 び振動による撹拌の効果によって試料融液の見かけ上の 熱伝導度が増加したためと考えられる.

対流の効果の内,熱対流に関しては,Krishnamurtiの 報告では、いずれの液体においてもレイリー数 Ra が 1700 未満の時には無対流であることが示されている¹⁷⁾.

$$Ra = \left(\frac{g\beta}{\kappa_{\rm V}}\right)\Delta T \cdot l^3 \tag{4}$$

g:重力加速度
β:熱膨張係数
κ:熱拡散率
ν:動的粘性率
ΔT:温度差
/:試料容器の半径
落下塔で得られる 10⁻³G 環境での Table 1 で示された試
料の熱伝導度測定時のレイリー数の代表値を Table 2 にま

料の熱伝導度測定時のレイリー数の代表値を Table 2 にま とめた. これらの試料のレイリー数は,試料容器の大き い Hg で 140 程度,その他の試料では 10 未満であり,落 下実験中には熱対流の影響は皆無であると言って良い.

もう 1 つの対流であるマランゴニ対流については微小 重力下でその影響が顕在化すると考えられる.多くの場 合には,駆動力である自由界面を極力減らす方向での対 応を行うに留まっており,定量的な評価を行うには至っ

Thermal Thermal Kinematic expansion Δт Ra Temperatur Viscosity^c Sample diffusivityb coefficient $(10^{-4} 1/K)$ (K) $(10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})$ $(10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})$ (K) (-) Hg 295 1.80 3.9 0.12 4.5 136. Bi 997 1.40 12.8 0.1 88 5. Sn 977 0.99 23.5 0.144 5.8 1. Si 1.59 1713 17.8 0.315 6.9 1. InSb 977 1.16 14.4 0.254 8.7 1

Table 2 Data for calculating Ra

a) These data were estimated from density data (refs. 18-20).

b) These data were measured by the hot-disk method in microgravity (refs. 11-14).

c) Refs. 18,20 and 21.

ていない.しかし,自由界面は試料容器の開口部のみで あり,仮にマランゴニ対流が起こった場合でも 1s 程度の 短時間微小重力環境下では試料融液の上部のみに限定さ れるため,熱対流ほど顕著な影響は現れないと考えられる.

これらの考察より,落下塔による短時間微小重力下で は、対流の影響は無視し得るほど小さいと考えて差し支 えないと考えられる.

次に、ホットディスク法の測定条件を検証した.ホッ トディスク法では、通常、試料の大きさや熱拡散率によ ってホットディスセンサーの半径や出力、測定時間を最 適になるように選択することで、幅広い熱伝導度の測定 領域を確保している.しかし、落下塔による実験では、 測定時間や実験装置上の試料サイズの制約により自由度 が制限されており、測定結果の信頼性に影響を与える.

そこで、**Table 1**で示した試料について、微小重力下で 測定した熱拡散率の値を用いて、測定結果の信頼性を判 断するのに必要な(2)式及び(3)式の値を求めた.測定範囲 の最低温度と最高温度での結果を**Table 3**に示す.落下塔 による測定で利用可能な時間は[落下時間(1.4s)]-[待ち時 間(0.1s)=1.3s であり、いずれの試料融液においても解析 の目安である0値の概ね 0.5 倍~1 倍が範囲に入っている.

また、ホットディスク法では、測定したデータを(1)式 にフィッティングして直線の傾きから熱伝導度を求める. 実際の計算においては、Fig.5に示すような直線関係の成 り立つ領域とプローブ深さΔpを参考にして測定範囲を限 定して再度計算を行う.この時、計算値と実測値の差分 のばらつき具合を確認しながら直線性の妥当性を判断す る.概ね抵抗値の比のばらつきが 10⁻⁶ 程度(温度で換算し たばらつきとして 10⁻³K 程度)以下であれば直線と見なせ る.ほとんど場合、このばらつきが上記の範囲に収まる ように Table 3 に示すように測定データの範囲を選択して いる.また、直線の妥当性を判断するために少なくも 20 個程度のデータ点数が必要であると考えられている.ホ ットディスク法で最小の測定時間を選択した場合、全体 の測定時間は 2.5s であり、この間に 200 点のデータを採 取することができるため、データの取得間隔は 0.0125s

Table 3 Data for calculating θ and Δ_p .

Sample	Temperature	Thermal diffusivity ^{a)}	Characteristic time (θ)	Measurement area		Probing depth(Δ_p) (t=1.3s)
				Start point	End point	(* 1.62)
	(K)	$(10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})$	(s)	(s)	(s)	(mm)
Hg	285	3.7	2.74	0.25	1.20	4.4
	295	3.9	2.63	0.25	1.20	4.5
Bi	571	8.6	1.08	0.05	1.00	6.7
	1083	13.5	0.69	0.05	1.00	8.4
Sn	521	14.6	0.64	0.05	0.60	8.7
	1083	26.5	0.35	0.05	0.60	11.7
Si	1690	16.9	0.55	0.80	1.20	9.4
	1713	17.8	0.52	0.80	1.20	9.6
InSb	824	14.6	0.64	0.05	1.00	8.7
	977	14.4	0.65	0.05	1.00	8.7





Fig. 5 Typical plots of resistance profile of hot-disk sensor as a function of dimensionless time function for molten InSb at 977K.

となる.このことから,20個のデータ取得にかかる時間 は 0.25s に相当し、少なくともこれ以上の測定時間が確 保できる必要がある.これも全ての試料で満たされてい る.ただ、Si 融液の測定の場合に関しては、ホットディ スクセンサーの絶縁層の厚みの問題で測定範囲が0値から 大きく外れた領域しか利用できず、単位体積当たりの比 熱の代入が必須であることがわかる.実際には、BiやSn 融液については、測定範囲のデータ点数で熱伝導度と熱 拡散率を同時に求めることが理論上は可能であるが、原 因不明なノイズなどによるデータ自体のばらつきが大き かったため、体積当たりの比熱の文献値を活用して、計 算式の直線性の向上を図っている.

プローブ深さ Δ_p については、微小重力時間の 1.3s を用 いて計算しているが、Si 融液と高温域の Sn 融液を除い てほとんど試料内に収まっていた.上記の 2 点について は測定時間を短くすることで実質的な Δ_p を短くして解析 を行っており、解析に支障の無いデータ点数は確保でき ている. このようにホットディスク法で金属融液を短時間微小 重力下で測定した場合,測定条件の観点からも問題なく 測定が可能であることがわかった.一方,熱拡散率の高 い Sn や Si 融液では測定データ数がかなり少なくなって おり,単位体積当たりの比熱を代入しなければならなか ったことを考えると,許容可能な範囲でホットディスク センサーの半径を増やす方向も検討すべきであることが わかった.

3.2 無対流下での金属融液の熱伝導度と Wiedemann-Franz 則との比較

落下塔によって得られる 1s 程度の微小重力環境で無対 流下の金属融液の熱伝導度が系統的に測定できることが わかった.この知見を用いて,金属融液の特性に繋がる 議論が可能かどうかを検討した.

金属融液の熱伝導度を議論する上で、Wiedemann-Franz 則はよく用いられている.

$$\lambda = L \frac{T}{r} \tag{5}$$

λ:測定試料の熱伝導度

L:ローレンツ数(2.445x10⁻⁸ WΩ/K²) T:試料温度

r: 測定試料の電気抵抗

しかし、この法則は固体金属を対象とした自由電子モデ ルから導かれたものであり、金属融液に適用できるかど うかははっきりしていない.これは、過去に測定された 金属融液の熱伝導度が対流の効果を含むかどうかが定か でないため、十分な議論に至っていないことも原因の1 つと考えられる.ここで、無対流下で測定した金属融液 の熱伝導度を用いて議論すれば、金属融液の特性に関し て、新たな知見が得られる可能性がある.

Figure 6 は, Table 1 で示した試料の無対流下で測定し た熱伝導度と Wiedemann-Franz 則から導出された熱伝 導度を示している.また,他の研究者による微小重力環 境や静磁場の効果を利用した無対流下での測定結果も同 時に示している. この図から, Hg と Bi 融液に関しては, およそ両者が一致していることがわかり、Hg については 本研究の結果と他の研究者らの結果が一致していること がわかる. 一方, Sn, Si, InSb 融液については, 低温域 の Sn 融液を除き、両者には明確な違いが見られる. ここ では InSb 融液に関しては本研究の結果と他の研究者の結 果は概ね一致していたが、Si 融液に関しては測定結果が Wiedemann-Franz 則の結果を挟むようになっていた. こ の違いについて、金属融液の半導体的性質の影響 23)や電 子-電子散乱効果²⁴⁾, 部分的な Si 原子間の共有結合の存 在 25), 不純物による電気伝導度への影響 26)など様々な説 が考えられており、金属融液の構造や特性の違いに由来 するであろうと推測することはできる. しかしながら, 現状ではデータがまだまだ不十分なため,推測の域を出





ないが,確実なデータの積み上げによって将来的には明 らかになると考えている.

4. まとめ

繰り返し性に優れた落下塔による短時間微小重力環境 と小型で 1s 程度の短時間測定に対応可能なホットディス ク法との組合せによって,対流の影響のない環境で金属 融液の熱伝導度が,これまでの微小重力実験と比較して 幅広い範囲で系統的に行えることを確認することができ た.ただ,系統的な議論を行うにはまだまだデータ量が 必要であるが,将来的には,より多くのデータが積み重 ねていくことで,金属融液の特性についても議論できる 可能性が示唆された.

参考文献

- H. Fukuyama, T. Tsukada, M. Watanabe, T. Tanaka, T. Baba and T. Hibiya: J. Jpn. Assoc. Crystal Growth, **30** (2003) 364 (in Japanese).
- H.-J. Fecht, R. Wunderlich, I. Battezzati, J. Etay, E. Ricci, S. Seetharaman and I. Egry: Euro Physics News, **39** (2009) 19.
- Thermophysical Properties of Matter, Vol.1, Thermal conductivity-Metallic Elements and Alloyus, ed. Y. S. Touloukian, R. W. Powell, C. Y. Ho and P. G. Klemens, Plenum Press, New York, 1970.
- S. Nakamura, T. Hibiya and F. Yamamoto: Microgravity Sci. Technol., 5 (1992) 156.
- S. Nakamura, T. Hibiya, F. Yamamoto and T. Yokota: Int. J. Thermophys., 12 (1991) 783.
- S. Nakamura and T. Hibiya: Microgravity Sci. Technol., 6 (1993) 119.
- S. Nakamura, T. Hibiya, T. Yokota and F. Yamamoto: Int. J. Heat Mass Transfer, 33 (1990) 2609.
- H. Fukuyama, T.Yoshimura, H. Yassuda and H. Ohta: Int. J. Thermophys., 27 (2006) 1760.
- H. Kobatake, H. Fukuyama and I. Minato: Appl. Phys. Lett., 90 (2007) 094102.
- H. Kobatake, H. Fukuyama, T. Tsukada and S. Awaji: Meas. Sci. Technol., **21** (2010) 025901.
- H. Nagai, F. Rossignol, Y. Nakata, T. Tsurue, M. Suzuki and T. Okutani: Mater. Sci. & Eng., A276 (2000) 117.
- 12) H. Nagai, Y. Nakata, T. Tsurue, H. Minagawa, K. Kamada, S. E. Gustafsson and T. Okutani: Jpn. J. Appl. Phys., **39** (2000) 1405.
- 13) H. Nagai, M. Mamiya, M. Castillo and T. Okutani: Jpn. J.

Appl. Phys., 45 (2006) 6455.

- H. Nagai, M. Mamiya and T. Okutani: Jpn. J. Appl. Phys., 46 (2007) 7920.
- 15) S. E. Gustafsson: Rev. Sci. Instrum., 62 (1991) 797.
- H. Nagai: J. Soc. Inorg. Mater., Jpn., 14 (2007) 489 (in Japanese).
- 17) R. Krishnamurti: J. Fluid Mech., 60 (1973) 285.
- Smithells Metals Reference Book 7th, ed. E. A. Brande, G. B. Brooks, Chap. 14, p.6, Butterworth, Heinemann, London, 1992.
- 19) M. Gomez, L. M. Garin, P. bedon and P. Desre: Bull. Soc. Chim. France, **7-8** (1976) 1030.
- 20) V. M. Glazov, S. N. Chizhevskaya and N. N. Glagoleva: Liquid Semiconductor, ed. A. Tybulewicz, p. 319, Plenum Press, New York, 1969.
- T. Iida, Z. Morita and S. Takeuchi: Nihon Kinzoku Gakkai-shi, **39** (1975) 1169 (in Japanese).
- 22) Reactor Handbook Engineering, ed. United State Atomic Energy Commission, Chap. 2.2, p.253, McGraw-Hill Book Company, New York, 1955.
- 23) V. I. Fedorov and V. I. Machuev: High Temp., 8 (1970) 419.
- E. Yamasue, M. Susa, H. Fukuyama and K. Nagata: Int. J. Thermophys., 24 (2003) 713.
- 25) J. T. Okada, P. H.-L. Sit, Y. Watanabe, Y. J. Wang, B. Barbiellini, T. Ishikawa, M. Itou, Y. Sakurai, A. Bansil, R. Ishikawa, M. Hamaishi, T. Masaki, P.-F. Paradis, K. Kimura, T. Ishikawa and S. Nanao: Phys. Rev. Lett., **108** (2012) 067402.
- 26) E. Yamasue, M. Susa, H. Fukuyama and K. Nagata: J. Crystal Growth, 234 (2002) 121.

(2014年7月30日受理, 2014年10月1日採録)